

公司代码：605358

公司简称：立昂微



杭州立昂微电子股份有限公司
2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3、 公司全体董事出席董事会会议。
- 4、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户中股份数量）为基数，向全体股东每股派发0.15元现金红利（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本为671,377,810股，扣除回购专户中股份数量2,591,500股，现金股利分派的股份基数为668,786,310股，以此计算预计派发现金红利100,317,946.50元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1、 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	立昂微	605358	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴能云	李志鹏
联系地址	杭州经济技术开发区20号大街199号	杭州经济技术开发区20号大街199号
电话	0571-86597238	0571-86597238
传真	0571-86729010	0571-86729010
电子信箱	wny@li-on.com	lizhipeng@li-on.com

2、报告期公司主要业务简介

(1) 业务概况

公司是国内极少数的半导体垂直一体化平台型企业，横跨半导体硅片、功率半导体、化合物半导体三大细分行业，实现了横向多赛道覆盖与纵向关键环节的深度融合，形成了从前端核心材料到中后端高端芯片的完整产业闭环。

公司三大业务板块——半导体硅片、半导体功率器件芯片、化合物半导体射频及光电芯片，如驱动公司发展的“三驾马车”，各自聚焦细分领域，相互支撑、协同发展，已建立起行业领先的市场地位与核心竞争力。三大板块并非孤立的业务单元，而是依托共同的技术底蕴、共享的制造平台与协同的客户资源，形成的有机整体。这种复合型业务架构，共同构建了从硅片到芯片的一站式产品与解决方案平台，精准服务于能源革命、智能计算与无线连接的时代需求，构筑起抵御行业周期波动的战略纵深。

报告期内，公司持续聚焦核心主业，深耕技术创新，优化产品结构，积极把握新能源、汽车电子、新一代通信、卫星互联网、人工智能、机器人、无人机等高景气赛道的战略机遇，推动核心业务稳健发展，整体经营质量与核心竞争力实现持续提升。

半导体硅片业务：公司主营6英寸、8英寸、12英寸半导体硅抛光片及硅外延片，产品覆盖轻掺、重掺、N型、P型等多品类，广泛应用于逻辑芯片、存储芯片、功率器件、模拟芯片、传感器等领域，下游覆盖新能源汽车、储能、新一代通信、工业控制、人工智能、消费电子、AI服务器和数据中心等高端市场。轻掺硅片具有高电阻率、低缺陷密度、晶体完整性优异的特点，主要作为逻辑芯片、存储芯片、模拟及射频芯片的基础衬底，在产业链中处于芯片制造最前端，决定芯片性能、良率与可靠性，是高端制程不可或缺的核心材料。重掺硅片通过高浓度掺杂实现超低电阻率，主要用于功率器件、高压器件、大电流芯片，能够显著提升器件导通效率与散热能力。8英寸硅片主要面向功率器件、电源管理、汽车电子等成熟工艺平台，12英寸硅片则面向先进制程与高端功率芯片。

品类	主要产品	应用领域	应用场景
抛光片	12英寸轻掺抛光片	计算机、通信、汽车、能源、家电、医疗、照明、新一代通信、AI以及工业控制	应用于存储器（内存与闪存）、电源管理、显示驱动、云计算、AI等领域高性能模拟芯片。
	12英寸超低氧抛光片		应用于新能源汽车电能转换、轨道交通变压调速、智能电网能源分配等。
	12英寸重掺抛光片		应用于消费电子、汽车电子、电机驱动、工业变频器、工业控制、嵌入式系统、新能源发电、图像识别、智能成像、自动驾驶、AI服务器等。

	8 英寸轻掺抛光片		应用于新能源汽车快充技术、空调压缩机、太阳能逆变器等。
	8 英寸重掺抛光片		应用于新能源/风能逆变器、储能变流器、充电桩、工业电子、伺服驱动器、快充适配器、路由器/光猫电源接口、手机充电端口等。
	6 英寸轻掺抛光片		应用于 RF 前端芯片、微波组件、压力传感器、加速度计/陀螺仪、温度传感器、磁场传感器等 MEMS 器件。
外延片	12 英寸轻掺外延片	计算机、通信、汽车、能源、家电、医疗、照明、新一代通信、AI 以及工业控制	应用于高端处理器 CPU/GPU、AI 加速器、Wi Fi 控制器、汽车电子、通讯设备、云计算等高算力逻辑器件。
	12 英寸重掺磷外延片		应用于消费电子、电机驱动、工业变频器、新能源发电、AI 服务器等。
	12 英寸重掺砷外延片		应用于消费电子、家用电器、电动车、嵌入式系统、工业控制、汽车电子、工业电子等。
	12 英寸重掺硼外延片		应用于图像识别、智能成像、自动驾驶、AI 控制等。
	8 英寸重掺砷外延片		应用于新能源/风能逆变器、储能变流器、充电桩、工业电子、伺服驱动器、快充适配器、路由器/光猫电源接口、手机充电端口等。
	8 英寸重掺磷外延片		应用于锂电池保护板、耳机充电盒、医疗器械的高压电源转换、风力发电的变流器的 DC-AC 转换模块、车载 OBC 模块等。
	6 英寸重掺外延片		应用于 USB 接口、充电器接口、路由器/光猫电源接口、耳机充电盒、SIM 卡插槽、服务器/通信电源电压转换、医疗器械的高压电源转换、工业变频器、通信基站电源、新能源/风能逆变器、储能变流器、充电桩、风力发电变流器的 DC-AC 转换模块、车载 OBC 模块、锂电池保护板等。

公司半导体硅片业务重点发展 8 英寸、12 英寸重掺硅片与轻掺硅片，其中 12 英寸硅片已覆盖 14nm 以上技术节点逻辑电路和存储电路，以及客户所需技术节点的图像传感器件和功率器件。

半导体功率器件芯片业务：公司以特色工艺 6 英寸功率器件芯片为核心，形成 SBD（肖特基二极管，沟槽型和平面型）芯片、FRD（快恢复二极管）芯片、MOSFET（金属氧化物层半导体场效应晶体管）芯片、TVS（瞬态抑制二极管）芯片等系列化产品布局。产品主要应用于新能源汽车、新能源逆变器、储能变流器、充电桩、工业电源、AI 服务器电源、白色家电等场景，是电能转换与功率控制的核心元器件。SBD 基于金属-半导体势垒结构，利用肖特基势垒实现低正向压降、超快开关速度，无反向恢复电荷，显著降低开关损耗。在产业链中为功率转换核心芯片，是车载电源、

新能源逆变器、快充适配器的关键整流器件，保障系统高效、低噪、高可靠运行。FRD 通过特殊掺杂与工艺优化反向恢复特性，兼具高耐压与快速关断能力，适配高频、高压功率回路。作为功率回路核心续流/整流器件，广泛用于新能源汽车电机控制器、新能源逆变器、工业 UPS，提升系统效率与稳定性。MOSFET 以栅极电压控制沟道导通，输入阻抗高、开关速度快、驱动简单，支持高频、高效功率控制。在产业链中为核心功率开关器件，覆盖新能源汽车 OBC、车载 DC-DC 变换器、新能源组串逆变器、服务器电源，是电能转换与系统控制的核心执行单元。TVS 利用雪崩击穿或齐纳击穿特性，在纳秒级吸收浪涌电压，保护后级电路免受过压损坏。作为电路保护核心器件，广泛用于汽车电子控制单元、通信设备、消费电子接口，保障系统在静电、浪涌冲击下安全稳定，是保障系统安全运行的关键基础器件。

品类	主要型号	应用领域	应用场景
SBD	20V-250V	汽车、新能源、储能、工控、家电、照明	应用于新能源组件、电源适配器、照明驱动、车载充电、工控续流、信号处理等。
MOSFET	400V-1500V		应用于电源适配器，马达驱动电源，LED 照明驱动等。
TVS	3V-38V		应用于通信、工业及汽车电路中稳压及高压保护电路等。
FRD	650V		应用于电动汽车充电桩、不间断电源、分布式新能源逆变器、感应加热等。
	750V		应用于 AI 服务器不间断电源、车载充电机、高低压电源变换器、新能源逆变器、储能系统等。
	950V		应用于新能源逆变器、工业电源、LED 照明等。
	1200V		应用于大型集中式新能源电站的逆变器、电机驱动、车载充电机等。
IGBT	600V-1200V	应用于新能源汽车电控系统、新能源逆变器、家电变频、LED 驱动等。	

公司半导体功率器件芯片业务重点发展车规级功率器件芯片及高附加值产品，覆盖 650V - 1200V 全电压平台，在新能源与工业控制功率半导体领域形成稳定的市场竞争力。

化合物半导体射频及光电芯片业务：公司主要产品是 HBT（异质结双极晶体管）、pHEMT（赝配高电子迁移率晶体管）、VCSEL（垂直腔面发射激光器）及 GaN-on-SiC（碳化硅基氮化镓）芯片，广泛应用于轨道卫星通信（高、中、低）、新一代通信、导航系统、车载激光雷达、智能驾驶、人形机器人、扫地机器人、无人机、光通信及手机终端等高端场景。HBT 基于砷化镓异质结，兼具高频率、高功率密度与线性度，适配射频功率放大。作为射频功率核心器件，用于手机射频前端、卫星通信终端、无线基站，保障信号大功率、高效率发射。pHEMT 基于砷化镓/铝镓砷异质结构，利用二维电子气实现超高频率、低噪声、高增益，适配毫米波与微波频段。在产业链中为射频前端核心放大器件，用于新一代通信基站、低轨卫星通信、雷达系统，实现信号低噪放大与远距离

传输。VCSEL 以垂直谐振腔结构，实现单模/多模激光发射，具有低阈值、高调制速率、易阵列集成特性。在产业链中为光电发射核心芯片，用于车载激光雷达、3D 传感、数据中心光互联，是智能驾驶、机器视觉的核心感知光源。GaN-on-SiC 芯片是以碳化硅为衬底、氮化镓为有源层，结合 GaN 高频、高功率与 SiC 高热导率优势，实现高压、高频、高温稳定工作。作为宽禁带射频/功率核心器件，突破硅基器件性能极限，提升系统功率密度与能效，用于新一代通信基站功放、卫星通信、新能源汽车车载电源、工业高频电源，是下一代射频与功率系统的核心升级方向。

品类	主要型号	应用领域	应用场景
HBT	High Linear/Gain/Eff./Rugg	无线通信、微波毫米波、光通信、激光器等	应用于新一代通信、无线局域网、新一代通信基站、物联网、车联网等。
pHEMT	0.5 μm SW; 0.25 μm E/D for PA/LNA/SW 0.15 μm E/D for PA/LNA/SW		应用于低轨卫星通信、卫星及地面终端等。
VCSEL	Flash/1D/2D VCSEL		应用于高阶智能辅助驾驶、无人驾驶、机器人、车载激光雷达、光通信、3D 感应、医疗健康、VR/AR 等。
碳化硅基氮化镓	0.45 μm /0.25 μm Power		应用于基站、无人机、卫星通信、机器人等。

公司化合物半导体射频及光电芯片业务以 6 英寸 GaAs（砷化镓）射频芯片与 VCSEL 光电芯片为核心，构建覆盖射频放大、信号发射与光电探测的完整产品体系，具备自主可控的 6 英寸晶圆制造工艺壁垒，高端产品实现规模化突破。

（2）经营模式

公司采用“半导体硅片、半导体功率器件芯片、化合物半导体射频及光电芯片”三轮驱动、纵向一体化协同的经营模式，构建完整产业链布局。该模式通过各板块梯次发展与协同驱动，实现短期盈利稳定与长期增长动能结合，区别于单一业务或单一环节企业受行业周期与市场需求波动影响较大的局限。核心逻辑为：依托盈利稳定的中小尺寸硅片产品支撑大尺寸硅片的研发与产业化投入，以具有行业领先水平的重掺硅片业务为牵引带动轻掺硅片业务的技术创新和产能爬坡，持续巩固硅片板块全尺寸竞争优势；同时以成熟的半导体硅片及半导体功率器件芯片业务为基础，为化合物半导体射频及光电芯片业务提供全方位支撑，带动射频及光电芯片业务快速实现技术突破与产能放量，形成“成熟业务稳盈利、攻坚业务快突破、新兴业务高增长”的梯次发展格局。

在此模式下，硅片板块为功率器件芯片板块提供核心衬底材料自主供应，降低原材料采购成本与供应链风险，提升产品交付稳定性；功率器件芯片为硅片板块提供稳定的内部需求、高效的技术反馈和市场资源，消化硅片产能的同时推动硅片产品向定制化、高端化升级，实现“材料与器件的双向赋能”；射频及光电芯片业务的高成长性为公司打开长期成长空间，在卫星互联网、激光雷达、机器人、无人机等终端应用领域占据先发优势。这种全产业链的协同效应是公司的核心价值。

（3）市场地位

公司三大业务板块，凭借产业链上下游整合优势、领先核心技术、优质客户资源及完善产能布局，成功打造协同互补、梯次发展的全链条产业生态，各业务板块构建显著竞争壁垒，均居细分行业龙头地位，在行业内具备较高知名度和品牌影响力。

在半导体硅片领域，公司是国产半导体硅片产业的先行者，是我国较早从事半导体硅片制造的企业之一，在硅片领域拥有完整的自主知识产权，建立了完善的单晶炉热场设计理论和大直径硅单晶生长理论，具备深厚的技术积累与市场基础。在12英寸大硅片方面持续推进研发攻关与产能建设，现已跻身第一梯队，成为支撑国内半导体产业链自主可控的主流供应商。公司作为我国半导体硅片行业领先企业及重掺领域龙头企业，也是国内少数能够同时规模化生产全尺寸半导体硅片的企业之一。2025年，公司全尺寸硅片出货量折合4.78亿平方英寸，约占全球硅片出货量的3.68%。拥有全球产能及市占率最大的6英寸硅片生产基地、国内单体产能规模最大的8英寸硅片生产基地以及国内主要的12英寸硅片生产基地。重掺系列硅片在国内市场占据绝对领先地位，其中8英寸在国内主要客户端的国产采购占比约40%，12英寸重掺砷、重掺磷低电阻产品在国内客户端的国产采购占比超过50%，定价能力与国际巨头相当。重掺锑、超低阻重掺砷、砷烷外延等特殊规格产品在国内实现独家供应。

在半导体功率器件芯片领域，公司作为国内特色工艺路线功率器件芯片制造者，依托自产硅片形成的全链条协同优势，公司构建了特色工艺技术和突出的成本控制能力，实现了从材料到芯片的自主可控。公司车规级产品比例不断提升，是博世、大陆集团、法格电子、台湾半导体、安世等国际顶级汽车电子厂商的合格供应商，是比亚迪、长城、小米等国内主流车企的供应商；在新能源与工业领域，光伏用控制芯片全球市场占有率超过30%；应用于新能源电控系统的FRD产品成功进入国内某重点逆变器制造厂商的供应链，实现了对原海外主流供应商的替代升级，成长为该客户的核心供应商。公司产品广泛应用于新能源汽车、储能及工业控制场景，是绿色能源核心器件的赋能者。

在化合物半导体射频及光电芯片领域，公司是国内射频及光电芯片技术的重要突破者。作为国内较早建成6英寸砷化镓射频芯片商业化产线的企业，公司长期专注于HBT、pHEMT、BiHEMT、VCSEL及GaN-on-SiC等先进工艺的研发与量产，构建了布局完善、技术领先的高壁垒核心技术体系。公司是国内少数具备大规模量产能力的化合物半导体射频及光电芯片制造平台，技术与产能均处于全球前列，尤其在VCSEL与GaN-on-SiC工艺上实现了引领性突破：公司目前是中国大陆独家、全球唯二能够稳定量产二维可寻址VCSEL芯片的厂商，该技术已成功应用于高端激光雷达领域；公司是国内唯一稳定供应星载0.15 μm E/D-pHEMT双工艺射频芯片的厂商，有效打破了国外垄断。此外，公司开发的6英寸GaN-on-SiC晶圆性能已达到国际先进水平，全方位巩固了公司在该领域的核心竞争地位。

（4）所处行业情况

2025年，全球半导体行业逐步走出周期底部，稳步进入复苏上行通道，行业整体景气度持续攀升。WSTS（世界半导体贸易统计组织）数据显示，2025年全球半导体市场规模达7,280亿美元，同比增长15.40%，复苏态势明确。国内半导体产业同步受益于国产替代进程加速与人工智能、新能源、智能驾驶等新兴应用场景的双重驱动，呈现出“高端化、规模化、差异化”的鲜明发展特征，产业竞争力持续提升。

从各细分行业来看，公司所处三大核心领域均呈现差异化高景气发展态势，具体如下：

在半导体硅片领域，2025年全球市场呈现“量增价减”的复苏特征，行业景气度拐点正式显现。SEMI（国际半导体产业协会）分析报告显示，2025年全球硅片出货量同比增长5.80%，达到129.73亿平方英寸，标志着全球硅片出货量正式重回增长通道；但同期硅片销售额同比下滑1.2%至114亿美元，反映出行业价格环境仍处于承压状态。这一“量价背离”态势的形成，主要源于两大因素：一方面，受人工智能应用快速渗透驱动，逻辑芯片用先进外延片与高带宽内存（HBM）用抛光片需求持续强劲，直接拉动整体出货量增长；另一方面，传统半导体应用领域需求依旧疲软，行业整体价格环境尚未得到根本改善，进而导致销售额出现下滑。

在功率半导体领域，2025年全球市场在新能源汽车、储能、工业变频等绿色能源应用的强劲拉动下，保持高速增长态势。根据Global Market Insights（全球市场洞察公司）数据，2025年全球功率半导体市场规模达到557亿美元，其中新能源领域（含新能源汽车、储能）贡献了约40%的市场增长，成为行业增长的核心引擎。中国报告大厅数据显示，2025年中国功率半导体器件市场规模达212亿美元，占全球市场份额的38.20%，近五年复合年增长率达15.60%，市场增长潜力显著。其中，新能源汽车是功率半导体最主要的增长驱动力，据行业测算，纯电动汽车所使用的功率半导体价值量约为传统燃油汽车的5至8倍。中国汽车工业协会发布的数据显示，2025年我国汽车产销量均突破3,400万辆，再创历史新高，其中新能源汽车产销量均超1,600万辆，国内新车销量占比突破50%，直接带动车规级功率器件需求爆发式增长。此外，国家能源局数据显示，2025年全国光伏新增装机3.17亿千瓦，同比增长14%；全国光伏发电装机容量达到12亿千瓦，同比增长35%，新能源领域的快速发展进一步释放了功率半导体的市场需求。

在化合物半导体领域，2025年市场在功率、射频及光电子三大核心应用领域持续积蓄增长动能，发展势头迅猛。根据Fortune Business Insights（财富商业洞察）数据，2025年全球化合物半导体市场规模达到423.60亿美元，行业增长空间广阔。其中，射频芯片领域受益于新一代通信基站建设持续推进、低轨卫星互联网快速发展，需求保持稳步增长；光电芯片则依托智能驾驶（激光雷达）、AI终端（机器人视觉）等新兴场景的爆发式增长，需求激增。QYResearch（恒州博智）数据显示，2025年全球化合物半导体射频芯片市场销售额达到31.58亿美元；中商产业研究院分析数据显示，2025年中国射频前端芯片市场规模已突破1,150亿元，同比增长约15%；中国激光雷达市场规模预计达240.70亿元，同比增长超70%，为化合物半导体产业发展提供了强劲支撑。

总体来看，2025年公司所处行业整体呈现“复苏上行、国产加速、高端突破、协同发展”的发展特点，既为公司发展提供了广阔的市场空间和政策机遇，也带来了技术快速迭代、国际市场竞争加剧等方面的挑战。公司所处的半导体硅片、功率半导体、化合物半导体三大细分行业，均处于行业高景气发展阶段，充分受益于下游新兴赛道需求爆发与国产替代红利，行业发展前景广阔，为公司核心业务的稳健发展奠定了坚实的行业基础。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	1,922,470.11	1,932,283.05	-0.51	1,827,599.25
归属于上市公司股东的净资产	719,862.10	733,773.09	-1.90	797,235.30
营业收入	359,091.90	309,231.66	16.12	268,966.99
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	355,130.59	306,341.82	15.93	266,785.20
利润总额	-29,137.41	-55,203.64	不适用	-9,900.75
归属于上市公司股东的净利润	-14,244.42	-26,575.71	不适用	6,575.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,279.28	-26,595.86	不适用	-10,552.44
经营活动产生的现金流量净额	83,864.40	81,096.60	3.41	102,679.73
加权平均净资产收益率(%)	-1.96	-3.44	增加1.48个百分点	0.82
基本每股收益(元/股)	-0.21	-0.39	不适用	0.10
稀释每股收益(元/股)	-0.21	-0.39	不适用	0.10

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	82,043.94	84,534.24	97,374.41	95,139.31
归属于上市公司股东的净利润	-8,103.58	-4,598.94	1,906.47	-3,448.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,125.61	-4,485.26	-1,494.93	-4,173.48
经营活动产生的现金流量净额	11,751.57	22,685.14	22,122.30	27,305.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

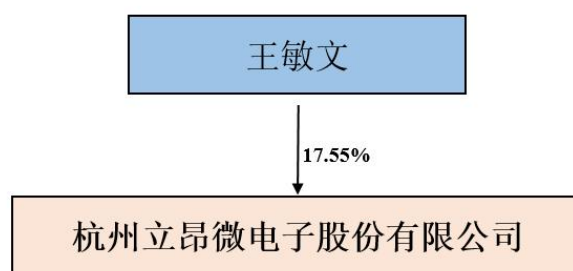
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					88,952		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					92,835		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售 条件 的股 份数 量	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
王敏文		117,831,266	17.55		质押	56,000,000	境内 自然 人
宁波泓祥和创业投 资合伙企业（有限 合伙）		39,958,224	5.95		无		其他
香港中央结算有限 公司	4,245,408	13,779,533	2.05		无		境外 法人
宁波利时信息科技 有限公司	-16,510,179	12,854,021	1.91		质押	7,825,000	境内 非国 有法 人
宁波泓万企业管理 合伙企业（有限合 伙）		12,267,878	1.83		无		其他
国投创业投资管理 有限公司—国投高 新（深圳）创业投 资基金（有限合 伙）	-8,711,000	11,455,527	1.71		无		其他
王式跃	643,916	10,407,202	1.55		无		境内

							自然人
韦中总	390,400	9,028,971	1.34		无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	455,112	7,955,233	1.18		无		其他
马名希		6,190,983	0.92		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人王敏文持有泓祥投资 78.50% 出资份额，持有泓万投资 55.16% 出资份额，为一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

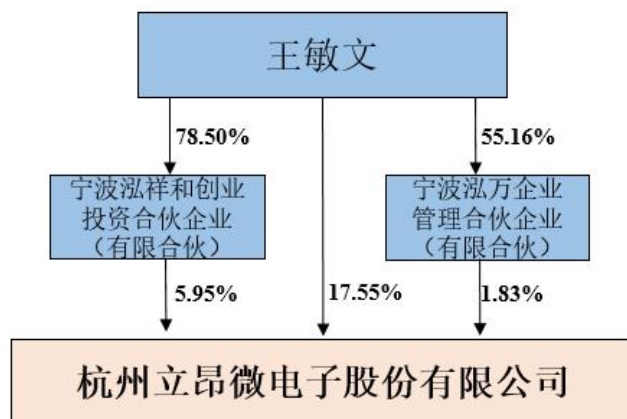
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5、公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 359,091.90 万元，同比增长 16.12%，其中实现主营业务收入 355,130.59 万元，同比增长 15.93%，创出历史新高。从产品销售金额来看，半导体硅片业务收入 267,868.04 万元（含对母公司的 29,413.74 万元），同比增长 19.66%，其中 12 英寸硅片收入 85,937.36 万元，同比增长 65.63%；半导体功率器件芯片业务收入 83,931.83 万元，同比略有下降，其中 FRD 芯片收入 17,841.78 万元，同比增长 96.18%；化合物半导体射频及光电芯片业务收入 32,744.47 万元，同比增长 10.84%，其中 VCSEL 芯片收入 4,635.38 万元，同比增长 723.30%，pHEMT 芯片实现收入 4,194.60 万元，同比增长 18.75%。从产品销量情况来看，各业务板块呈现差异化增长与突破性发展态势，高端产品迭代升级与新场景应用拓展成为公司增长的核心引擎。2025 年，公司硅片总销量折合 6 英寸 1,939.74 万片（含对母公司的 248.16 万片），同比增长 28.22%，其中 12 英寸销量 178.57 万片（折合 6 英寸 714.29 万片），同比增长 61.90%；半导体功率器件芯片销量 193.37 万片，同比增长 6.01%，其中 FRD 销量 22.68 万片，同比增长 87.04%；化合物半导体射频及光电芯片销量 4 万片，同比基本持平。

报告期内，公司实现 EBITDA（息税折旧摊销前利润）111,971.85 万元，同比增长 75.86%；实现归属于上市公司股东的净利润-14,244.42 万元，同比减亏幅度达 46.40%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,279.28 万元，同比减亏幅度达 31.27%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润同比大幅减亏，主要得益于半导体硅片板块盈利能力的复苏。随着产品结构持续向高端化迭代升级，半导体硅片业务折合6英寸的平均销售单价自2025年第一季度起呈现逐季提升态势，加之产销规模的稳步扩张，尤其是12英寸硅片产销量实现大幅增长，硅片单位成本亦随之同步下降。在销售价格提升和单位成本下降的双重驱动下，合并口径半导体硅片业务的主营毛利率从2024年度的-1.82%上升至2025年度的5.64%，其中12英寸硅片负毛利率同比收窄显著，主营毛利率从-77.60%大幅收窄至-33.16%。受此影响，硅片业务特别是12英寸硅片本期计提的存货跌价准备金额也大幅缩减。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用